

10.11.2004

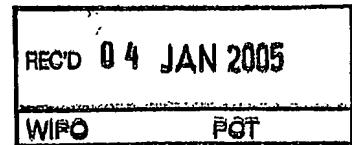
日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日  
Date of Application:

2003年11月19日



出願番号  
Application Number:

特願2003-389274

[ST. 10/C]:

[JP2003-389274]

出願人  
Applicant(s):

キヤノン株式会社

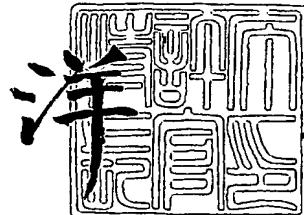


**PRIORITY  
DOCUMENT**  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2004年12月16日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

八 月



【書類名】 特許願  
【整理番号】 256607  
【提出日】 平成15年11月19日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 H04N 5/00  
【発明者】  
  【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内  
  【氏名】 亀島 登志男  
【特許出願人】  
  【識別番号】 000001007  
  【氏名又は名称】 キヤノン株式会社  
【代理人】  
  【識別番号】 100090273  
  【弁理士】  
  【氏名又は名称】 國分 孝悦  
  【電話番号】 03-3590-8901  
【手数料の表示】  
  【予納台帳番号】 035493  
  【納付金額】 21,000円  
【提出物件の目録】  
  【物件名】 特許請求の範囲 1  
  【物件名】 明細書 1  
  【物件名】 図面 1  
  【物件名】 要約書 1  
  【包括委任状番号】 9705348

**【書類名】特許請求の範囲****【請求項 1】**

光電変換素子と、  
前記光電変換素子にソースが接続され、ドレインにリセット用電源が接続されるリセット用トランジスタと、  
前記光電変換素子にゲートが接続され、ドレインに読み出し用電源が接続される読み出し用トランジスタと、  
前記読み出し用トランジスタのソースに接続された信号線と、  
前記読み出し用電源又は前記信号線と前記読み出し用トランジスタとの間に接続された選択用トランジスタと、  
前記信号線に接続された定電流源と、  
を有することを特徴とする光電変換装置。

**【請求項 2】**

前記光電変換素子、前記読み出し用トランジスタ、前記信号線及び前記定電流源は、単一の絶縁性支持体上に形成されていることを特徴とする請求項 1 に記載の光電変換装置。

**【請求項 3】**

前記信号線に接続された読み出し手段を有し、  
前記定電流源は、前記読み出し用トランジスタよりも前記読み出し手段から離間した前記信号線上の位置に設けられていることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の光電変換装置。

**【請求項 4】**

前記定電流源は、ゲートに定電流源用電源が接続された定電流源用トランジスタを有することを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれか 1 項に記載の光電変換装置。

**【請求項 5】**

前記定電流源用電源は、前記定電流源用トランジスタのゲートに、ドレイン-ソース間電圧を  $V_{ds}$ 、ゲート-ソース間電圧を  $V_{gs}$ 、しきい値電圧を  $V_{th}$  としたときに、 $V_{ds} > V_{gs} - V_{th}$  の関係が成り立つような電圧を供給することを特徴とする請求項 4 に記載の光電変換装置。

**【請求項 6】**

前記定電流源は、ゲートとソースとが相互に接続された定電流源用トランジスタを有することを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれか 1 項に記載の光電変換装置。

**【請求項 7】**

前記定電流源は、ゲートとソースとが抵抗を介して接続された定電流源用トランジスタを有することを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれか 1 項に記載の光電変換装置。

**【請求項 8】**

前記リセット用トランジスタ、前記読み出し用トランジスタ、前記選択用トランジスタ及び前記定電流源からなる群から選択された少なくとも 1 個は、アモルファスシリコン層又はポリシリコン層を用いて形成されていることを特徴とする請求項 1 乃至 7 のいずれか 1 項に記載の光電変換装置。

**【請求項 9】**

放射線を吸収し、前記光電変換素子が検知可能な波長帯域の光を放出する蛍光体層を有することを特徴とする請求項 1 乃至 8 のいずれか 1 項に記載の光電変換装置。

**【請求項 10】**

前記光電変換素子は、PIN 型フォトダイオード又は MIS 型センサであることを特徴とする請求項 1 乃至 9 のいずれか 1 項に記載の光電変換装置。

**【請求項 11】**

光電変換素子と、  
前記光電変換素子にソースが接続され、ドレインにリセット用電源が接続されるリセット用トランジスタと、  
前記光電変換素子にゲートが接続され、ドレインに読み出し用電源が接続される読み出

し用トランジスタと、

前記読み出し用電源又は前記信号線と前記読み出し用トランジスタとの間に接続された選択用トランジスタと、

を備えた画素が2次元状に複数配列され、

前記複数の画素に接続された複数の共通信号線と、

前記共通信号線に接続された定電流源と、

を有することを特徴とする光電変換装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】光電変換装置

【技術分野】

【0001】

本発明は、放射線撮影装置等の光電変換装置に関し、特に、寄生容量による感度低下の低減を図った光電変換装置に関する。

【背景技術】

【0002】

従来、アモルファスシリコンやポリシリコンを用いたセンサアレイの光電変換素子で光電変換された電荷を、マトリクス駆動によって容量へ転送して読み出す放射線撮影装置等の光電変換装置が知られている。

【0003】

図9は、従来の光電変換装置（放射線撮像装置）を示す模式的回路図である。図9に示すように、従来の光電変換装置では、図中破線で囲まれた画素に、PIN型フォトダイオードPDと選択用薄膜トランジスタ（TFT）STとが設けられており、このような画素が2次元に配列してセンサアレイ101が構成されている。これらの素子は、ガラス基板102上に形成されたアモルファスシリコン層及びポリシリコン層等を用いて構成されている。各画素のPIN型フォトダイオードPDの共通電極には電源からバイアス電圧Vsが印加されている。

【0004】

また、各画素の選択用TFT STのゲート電極は共通ゲート線Vg1～VgMに接続されている。共通ゲート線Vg1～VgMはシフトレジスタ（図示せず）等を備えたゲートドライバ104に接続されている。各選択用TFT STのソース電極は共通信号線Sig1～SigNに接続されている。共通信号線Sig1～SigNは、アンプAmp1～AmpN、アナログマルチプレクサMUX及びA/Dコンバータ（図示せず）等を備えた読み出し回路103に接続されている。

【0005】

このように構成された従来の光電変換装置では、ゲートドライバ104によるマトリクス駆動が行われ、撮影画像データが読み出し回路103に出力されて読み出される。

【0006】

次に、従来の放射線撮影装置等の光電変換装置に用いられるセンサアレイの画素の断面構造について説明する。図10は、従来の光電変換装置（X線撮像装置）の画素を示す断面図である。

【0007】

各画素において、ガラス基板201上に、ゲート電極層（下電極）202、絶縁層（アモルファスシリコン窒化膜）203、アモルファスシリコン半導体層204、n型アモルファスシリコン層205、ソース・ドレイン電極層（上電極）206が積層されて選択用薄膜トランジスタ（TFT）222が構成されている。また、ガラス基板上に、ソース・ドレイン電極層206の延出した部分（下電極層）、p型アモルファスシリコン層207、アモルファスシリコン半導体層208、n型アモルファスシリコン層209、上電極層210が積層されてフォトダイオード221が構成されている。更に、ガラス基板201上には、絶縁層203、アモルファスシリコン半導体層204、n型アモルファスシリコン層205、ソース・ドレイン電極層206が積層されて構成された配線部223も存在する。更に、これらを覆うアモルファスシリコン窒化膜等からなる保護層211が形成され、この上に接着層212を用いて蛍光体層213が接着されている。このような構造は、例えば特許文献1（特開平08-116044号公報）に記載されている。

【0008】

なお、蛍光体層213は、放射線（X線）を可視光に変換するために設けられている。一般的に、アモルファスシリコンを用いて構成されたフォトダイオードはX線に対する感度が極めて低い。蛍光体層213はガドリニウム系材料又はCsI（ヨウ化セシウム）等

から構成される。

【0009】

このような従来の光電変換装置（X線撮像装置）では、被写体を透過したX線が蛍光体層に入射すると、可視光に変換される。そして、可視光がフォトダイオードに入射する。フォトダイオードでは、半導体層で電荷が発生し、TFTがオンになると、順次読み出し回路に転送され、読み出される。

【0010】

しかしながら、従来の放射線撮影装置等の光電変換装置では、2次元的に配列した画素の数が多くなるに従って、共通信号線に大きな寄生容量が寄生し、出力電圧が大幅に低下することがある。つまり、図9に示すように、寄生容量Cgsは、選択用TFT STのゲートとソース電極との間に寄生し、1本の共通信号線に寄生する寄生容量の大きさは、当該共通信号線に接続される画素の数に比例して大きくなる。例えば、X線フィルム相当のエリアセンサを1画素 $200\mu\text{m} \times 200\mu\text{m}$ で縦横に $2000\text{個} \times 2000\text{個}$ 配置し、 $40\text{cm} \times 40\text{cm}$ のエリアセンサを作製した場合、1箇所の寄生容量Cgsの大きさが $0.05\text{pF}$ であるとしても、1本の共通信号線には $0.05 \times 2000 = 100\text{pF}$ の寄生容量が生じてしまう。

【0011】

一方、フォトダイオードPDのセンサ容量Cは $1\text{pF}$ 程度である。このため、可視光の入射によりフォトダイオードで発生した信号電圧をV1とすると、共通信号線上で観察できる出力電圧Voは「 $V_o = V_1 \times C_s / (C_s + C_{gs}) \times 2000$ 」となり、出力電圧Voは信号電圧V1の約 $1/100$ になってしまふ。

【0012】

従って、従来の放射線撮像装置等の光電変換装置では、このような出力電圧の大幅な低下のために、大面積のセンサを構成することができない。また、出力電圧の大幅な低下のために、読み出し回路のアンプで発生するノイズや外来ノイズの影響を受けやすく、高感度の光電変換装置を構成するのが困難な場合もある。定電流源や低ノイズアンプ等を読み出し回路に設ければノイズの影響を低減することが可能な場合もあるが、低ノイズアンプは特殊な回路であるため、コストの上昇等の問題が引き起こされてしまう。更に、低ノイズアンプは一般に消費電力が大きいため、読み出し回路の発熱の問題も無視できない。

【0013】

【特許文献1】特開平8-116044号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0014】

本発明は、寄生容量によるノイズの影響を低減することが可能であり、また、簡素な構成で低消費電力の読み出し回路で読み出し可能な光電変換装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0015】

本願発明者は、前記課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、以下に示す発明の諸態様に想到した。

【0016】

本発明に係る光電変換装置は、光電変換素子と、前記光電変換素子にソースが接続され、ドレインにリセット用電源が接続されるリセット用トランジスタと、前記光電変換素子にゲートが接続され、ドレインに読み出し用電源が接続される読み出し用トランジスタと、前記読み出し用トランジスタのソースに接続された信号線と、前記読み出し用電源又は前記信号線と前記読み出し用トランジスタとの間に接続された選択用トランジスタと、前記信号線に接続された定電流源と、を有することを特徴とする。

【発明の効果】

【0017】

本発明によれば、大面積のセンサを構成しても、寄生容量の増大による出力電圧の低下を抑えることができる。このため、ノイズの影響を受けにくくなり、高い感度が得られる。更に、低ノイズアンプや定電流源等の特殊な回路を用いなくても読み出し手段を構成することができる。また低消費電力で発熱の影響の小さい読み出し手段を構成することができる。更に、本発明に設けられる定電流源はガラス基板上に薄膜トランジスタを用いて形成することが可能である。このため、光電変換素子や他の薄膜トランジスタと同時に成膜形成することができ、コストの面で有利である。また、定電流源はガラス基板上において、読み出し手段から離間した場所に設けることができるため、信号線の抵抗の影響を低減することも可能である。

【発明を実施するための最良の形態】

【0018】

以下、本発明の実施形態について添付の図面を参照して具体的に説明する。

【0019】

(第1の実施形態)

先ず、本発明の第1の実施形態について説明する。図1は、本発明の第1の実施形態に係る光電変換装置、特にX線撮像装置の回路構成を示す回路図である。

【0020】

本実施形態においては、ガラス基板2上に2行2列(4個)の画素PE11、PE21、PE21及びPE22が設けられてセンサアレイ1が構成されているが、センサアレイ1を構成する画素の数はこれに限定されるものではない。各画素には、アモルファスシリコンを用いて形成されたPIN型フォトダイオードからなる光電変換素子PD及び光電変換素子PDが生成した信号電荷を蓄積する蓄積容量Csが設けられている。光電変換素子PD及び蓄積容量Csの一端は接地されており、他端は互いに接続されている。各画素には、更に、リセット用MOSトランジスタRT、選択用MOSトランジスタST及びソースフォロアMOSトランジスタ(読み出し用トランジスタ)FTが設けられている。リセット用MOSトランジスタRT、選択用MOSトランジスタST及びソースフォロアMOSトランジスタFTは、例えばアモルファスシリコン又はポリシリコンを用いて形成された薄膜トランジスタ(TFT)から構成されている。なお、蓄積容量Csは、光電変換素子PD自体に存在する容量の大きさが十分なものであれば設けられていなくてもよい。

【0021】

画素PE11及びPE12のリセット用MOSトランジスタRTのゲートには、共通の共通リセット線R1が接続され、画素PE21及びPE22のリセット用MOSトランジスタRTのゲートには、共通の共通リセット線R2が接続されている。また、各リセット用MOSトランジスタRTの一端はリセット用電源5に接続され、他端は光電変換素子PD及び蓄積容量Csに接続されている。

【0022】

画素PE11及びPE12の選択用MOSトランジスタSTのゲートには、共通の共通選択線S1が接続され、画素PE21及びPE22の選択用MOSトランジスタSTのゲートには、共通の共通選択線S2が接続されている。また、各選択用MOSトランジスタSTの一端はソースフォロア用電源(読み出し用電源)6に接続され、他端は当該画素内でソースフォロアMOSトランジスタFTのドレインに接続されている。

【0023】

画素PE11及びPE21のソースフォロアMOSトランジスタFTのソースには、共通の共通信号線S1g1が接続され、画素PE12及びPE22のソースフォロアMOSトランジスタFTのソースには、共通の共通信号線S1g2が接続されている。また、各ソースフォロアMOSトランジスタFTのゲートは、当該画素内で光電変換素子PD及び蓄積容量Csに接続されている。

【0024】

共通リセット線R1及びR2並びに共通選択線S1及びS2は、結晶シリコンを用いて形成されたシフトレジスタを備えた走査回路4に接続されている。また、共通信号線S1

g 1 及び S i g 2 は、結晶シリコンを用いて形成された読み出し回路 3 に接続されている。更に、共通信号線 S i g 1 及び S i g 2 には、ガラス基板 2 上に形成された定電流源 I が接続されている。読み出し回路 3 には、共通信号線 S i g 1 及び S i g 2 毎に、増幅器 A m p 1 及び A m p 2 が設けられており、これらの出力信号を外部に順次出力するアナログマルチプレクサ MUX が設けられている。また、センサアレイ 1 の受光面には、従来のものと同様に蛍光体層が設けられている。

#### 【0025】

次に、第1の実施形態に係る光電変換装置（X線撮像装置）の動作について説明する。図2は、第1の実施形態に係る光電変換装置（X線撮像装置）の動作を示すタイミングチャートである。図2中のR 1 及び R 2 は、夫々共通りセット線 R 1 、R 2 を介してリセット用MOSトランジスタ R T のゲートに印加されるリセットパルスを示し、S 1 、S 2 は、夫々共通選択線 S 1 、S 2 を介して選択用MOSトランジスタ S T のゲートに印加される選択パルスを示し、MUX\_C L K はアナログマルチプレクサ MUX に印加されるパルスを示す。

#### 【0026】

放射線（X線）が光電変換装置に連続して照射されている状態で、走査回路 4 が共通りセット線 R 1 にリセットパルスを印加すると、画素 P E 1 1 及び P E 1 2 の光電変換素子 P D の電位がリセットされた後、画素 P E 1 1 及び P E 1 2 の光電変換素子 P D が光電変換を開始し、蓄積容量 C s に信号電荷が蓄積される。また、走査回路 4 が共通りセット線 R 2 にリセットパルスを印加すると、画素 P E 2 1 及び P E 2 2 の光電変換素子 P D の電位がリセットされた後、画素 P E 2 1 及び P E 2 2 の光電変換素子 P D が光電変換を開始し、蓄積容量 C s に信号電荷が蓄積される。

#### 【0027】

そして、走査回路 4 が、共通りセット線 R 1 にリセットパルスを印加した後に共通選択線 S 1 に選択パルスを印加すると、光電変換素子 P D のリセット以降、画素 P E 1 1 及び P E 1 2 の蓄積容量 C s に蓄積されていた信号電荷が信号線 S i g 1 を介して読み出し回路 3 に読み出される。同様に、走査回路 4 が、共通りセット線 R 2 にリセットパルスを印加した後に共通選択線 S 2 に選択パルスを印加すると、光電変換素子 P D のリセット以降、画素 P E 2 1 及び P E 2 2 の蓄積容量 C s に蓄積されていた信号電荷が信号線 S i g 2 を介して読み出し回路 3 に読み出される。

#### 【0028】

読み出し回路 3 は、パルス MUX\_C L K に同期して、信号線 S i g 1 及び S i g 2 を介して出力されてきた信号を外部の処理装置等に出力する。

#### 【0029】

このような第1の実施形態では、全体的な回路の構成がソースフォロア回路となっている。従って、信号線 S i g 1 及び S i g 2 に寄生する寄生容量 P の影響を受けずに光電変換素子 P D により得られた信号を増幅して読み出すことができる。従って、大面積化に伴う出力の低下を回避することができる。このため、読み出し回路 3 内の増幅器 A m p 1 及び A m p 2 自体で生じるノイズや外来ノイズの影響を受けにくいという効果も得られる。従って、高い感度を得ることもできる。更に、光電変換素子 P D により得られた信号がソースフォロアで増幅されており、また、読み出し回路 3 に定電流源が不要なので、読み出し回路 3 の構成は簡素であり、廉価な汎用の素子を用いて構成することが可能である。即ち、従来技術のように、特殊で消費電力の大きい低ノイズアンプや低電流源を要しない簡単な構成の読み出し回路を実現することができる。

#### 【0030】

なお、上述の動作についての説明では、放射線（X線）を連続的に照射しているものとしているが、断続的に照射してもよい。また、X線撮像装置の構成に関し、選択用MOSトランジスタ S T がソースフォロアMOSトランジスタ F T のソース側に設けられていてもよい。また、定電流源の回路構成は、特に限定されるものではなく、例えば1又は2以上のTFTを組み合わせることにより構成することができる。

## 【0031】

## (第2の実施形態)

次に、本発明の第2の実施形態について説明する。図3は、本発明の第2の実施形態に係る光電変換装置、特にX線撮像装置の回路構成を示す回路図である。第2の実施形態では、第1の実施形態で用いられている定電流源Iの替わりに、アモルファスシリコンを用いて形成された薄膜トランジスタ(TFT)CTが設けられている。薄膜トランジスタCTのゲートには、定電流源用電源7から電圧が供給されている。このような構成では、定電流源を他のトランジスタ(リセット用、選択用、ソースフォロア用)等と同時に成膜して形成することができるため、簡易な製造プロセスで構成することができる。ここで、リセット用、選択用、ソースフォロア用、定電流源用の各薄膜トランジスタは積層する膜厚等を共通にしても良いし、又は個別の膜厚等にしても良い。また、不純物ドープの条件(n型又はp型)を共通にしても良いし、又は個別のドープ条件としても良い。更に、レーザーアニール等を用いて、一部をアモルファスシリコンで構成し、他の一部をポリシリコン化しても良い。

## 【0032】

なお、図3においては、薄膜トランジスタCT及び定電流源用電源7を備えた定電流源は、図11に示すように構成されている。この場合、定電流源を構成する薄膜トランジスタCTはn型、p型のいずれでも良い。

## 【0033】

例えば、薄膜トランジスタCTがn型の薄膜トランジスタである場合、薄膜トランジスタCTは、ソースードレイン間電圧Vds、ソースードレイン間電流Ids、ゲート-ソース間電圧Vgs及びしきい値電圧Vthに関し、図4に示すようなVds-Ids特性を示す。従って、薄膜トランジスタCTのゲート電圧を制御して「 $V_{ds} > V_{gs} - V_{th}$ 」が満たされる飽和領域とすることにより、薄膜トランジスタCTを定電流源として用いることができる。

## 【0034】

更に、上式に従えば、薄膜トランジスタCTがn型の薄膜トランジスタである場合、図12に示すように、ゲートとソースとを互いに接続することにより、簡単な構成で定電流源を構成することもできる。また、必要な電流値によっては、図13に示すように、ゲートとソースとの間に抵抗を設けても良い。図12又は図13に示す構成によれば、定電流源用電源が不要となる。

## 【0035】

## (第3の実施形態)

次に、本発明の第3の実施形態について説明する。図5は、本発明の第3の実施形態に係る光電変換装置、特にX線撮像装置の回路構成を示す回路図である。第2の実施形態では、薄膜トランジスタCTが画素と読み出し回路3との間に位置しているのに対し、第3の実施形態では、薄膜トランジスタCTが共通信号線上において、画素よりも読み出し回路3から離して位置している。つまり、薄膜トランジスタCTと読み出し回路3との間に画素が位置している。

## 【0036】

本実施形態によれば、第1及び第2の実施形態で得られる効果に加えて、共通信号線に抵抗成分が存在しても、読み出し回路3が読み出す信号出力に対する抵抗成分による電圧降下を回避することができるという更なる効果が得られる。

## 【0037】

## (第4の実施形態)

次に、本発明の第4の実施形態について説明する。図6は、本発明の第4の実施形態に係る光電変換装置、特にX線撮像装置の回路構成を示す回路図である。第4の実施形態においては、第3の実施形態に対し、共通信号線Sig1及びSig2に、読み出し走査用薄膜トランジスタ(TFT)RDTが設けられている。読み出し走査用薄膜トランジスタRDTは、ガラス基板2上の画素と読み出し回路3との間に形成されている。また、読み

出し回路3には、アナログマルチプレクサMUXが設けられておらず、各信号線からの出力信号は単一の増幅器AMPに入力されるようになっている。更に、読み出し回路3には、読み出し走査用薄膜トランジスタRDTのゲート電圧を走査する読み出し走査回路8が設けられている。

#### 【0038】

このように構成された第4の実施形態では、図7に示すように、第1の実施形態と同様にして蓄積容量Csに信号電荷が蓄積された後、信号線Sиг1用のクロック信号CLK1及び信号線Sиг2用のクロック信号CLK2に同期して読み出し走査用薄膜トランジスタRDTがオンとなり、蓄積されていた電荷が順次読み出し回路3により読み出される。

#### 【0039】

このような第4の実施形態によれば、読み出し回路3に必要な増幅器の個数は1個であり、他にはロジック回路等は必要なだけである。即ち、読み出し回路3の構成がより一層簡素になっている。従って、ノイズがより一層低くなり、より簡単な構成でより高い感度を得ることができる。本実施形態において、レーザーアニール技術等を用いて走査用薄膜トランジスタRDTをポリシリコンで形成することは、走査速度の観点から望ましい。

#### 【0040】

##### (第5の実施形態)

次に、本発明の第5の実施形態について説明する。図8は、本発明の第5の実施形態に係る光電変換装置、特にX線撮像装置の回路構成を示す回路図である。第4の実施形態では、選択用MOSトランジスタSTがソースフォロアMOSトランジスタFTのドレインに接続されているのに対し、第5の実施形態では、選択用MOSトランジスタSTがソースフォロアMOSトランジスタFTのソースと信号線Sиг1又はSиг2との間に接続されている。ソースフォロアMOSトランジスタFTのドレインは、ソースフォロア用電源6に直接接続されている。

#### 【0041】

このような第5の実施形態によっても、第4の実施形態と同様の効果が得られる。

#### 【0042】

なお、X線の検出だけでなく、蛍光体層を設けずに可視光をそのまま受光するようにしてもよい。また、光電変換素子としては、PIN型フォトダイオードだけでなく、MIS型センサ等を用いてもよい。MIS型センサを用いる場合は、リセット用トランジスタに接続されたリセット用電源が図示しない制御手段により出力電圧を制御可能な構成としてもよい。

##### 【図面の簡単な説明】

#### 【0043】

【図1】本発明の第1の実施形態に係る光電変換装置、特にX線撮像装置の回路構成を示す回路図である。

【図2】第1の実施形態に係るX線撮像装置の動作を示すタイミングチャートである。

【図3】本発明の第2の実施形態に係る光電変換装置、特にX線撮像装置の回路構成を示す回路図である。

【図4】第2の実施形態における薄膜トランジスタCTのVds-Ids特性を示すグラフである。

【図5】本発明の第3の実施形態に係る光電変換装置、特にX線撮像装置の回路構成を示す回路図である。

【図6】本発明の第4の実施形態に係る光電変換装置、特にX線撮像装置の回路構成を示す回路図である。

【図7】第4の実施形態に係るX線撮像装置の動作を示すタイミングチャートである。

【図8】本発明の第5の実施形態に係る光電変換装置、特にX線撮像装置の回路構成

を示す回路図である。

【図9】従来の光電変換装置（放射線撮像装置）を示す模式的回路図である。

【図10】従来の光電変換装置（X線撮像装置）の画素を示す断面図である。

【図11】定電流源の構成の一例を示す回路図である。

【図12】定電流源の構成の他の一例を示す回路図である。

【図13】定電流源の構成の更に他の一例を示す回路図である。

【符号の説明】

【0044】

1：センサアレイ

2：ガラス基板

3：読み出し回路

4：走査回路

5：リセット用電源

6：ソースフォロア用電源

7：定電流源用電源

8：読み出し走査回路

PE11、PE12、PE21、PE22：画素

PD：光電変換素子

Cs：蓄積容量

RT：リセット用MOSトランジスタ

ST：選択用MOSトランジスタ

FT：ソースフォロアMOSトランジスタ

CT：薄膜トランジスタ

RDT：読み出し走査用薄膜トランジスタ

Amp、Amp1、Amp2：増幅器

MUX：アナログマルチプレクサ

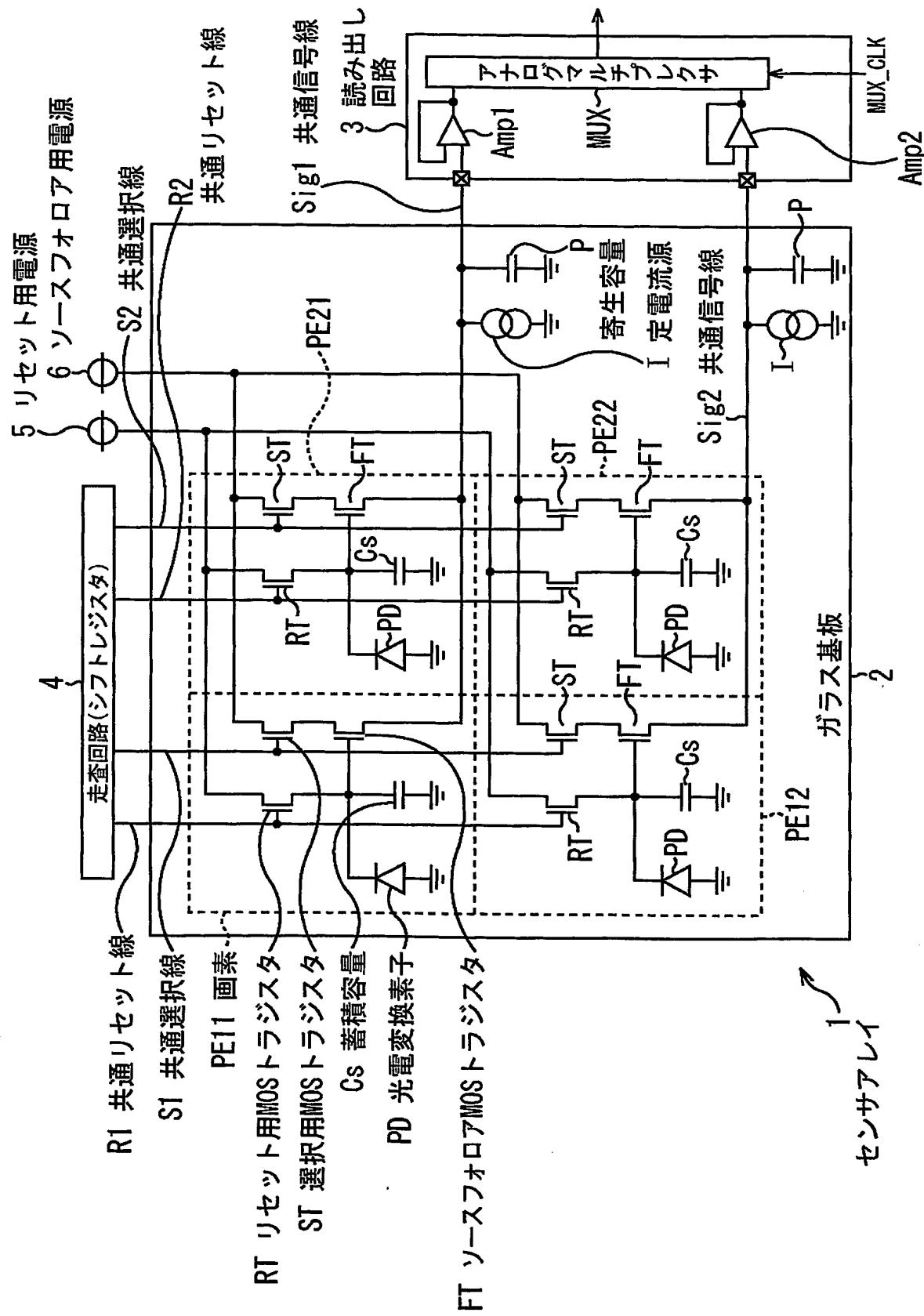
I：定電流源

R1、R2：共通リセット線

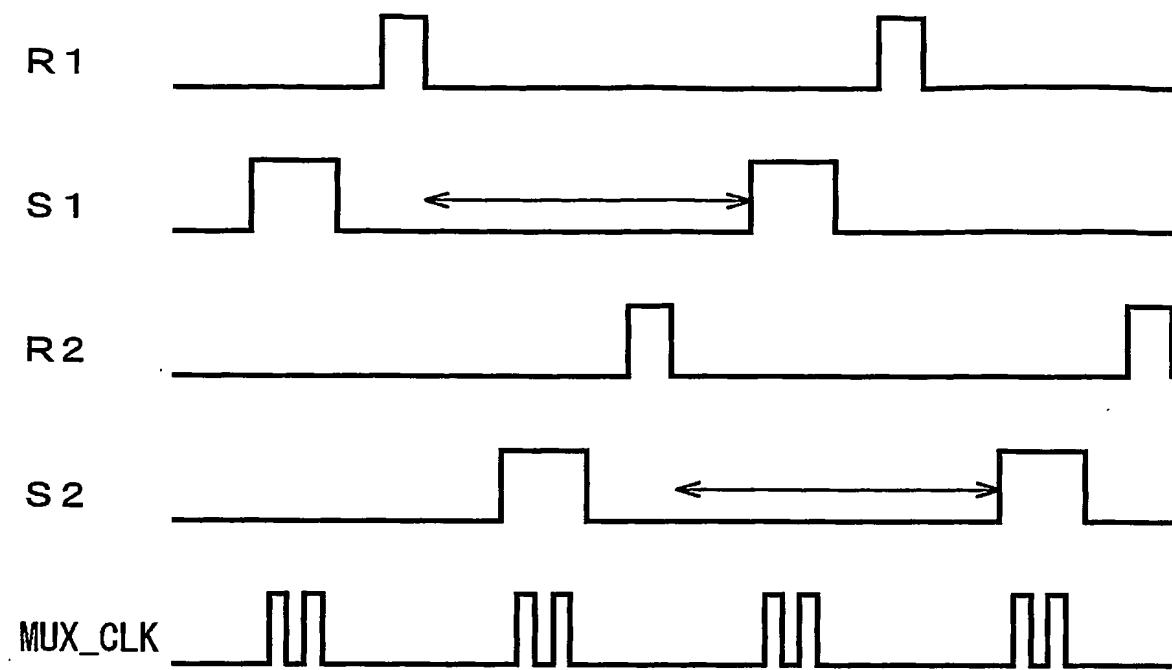
S1、S2：共通選択線

Sig1、Sig2：共通信号線

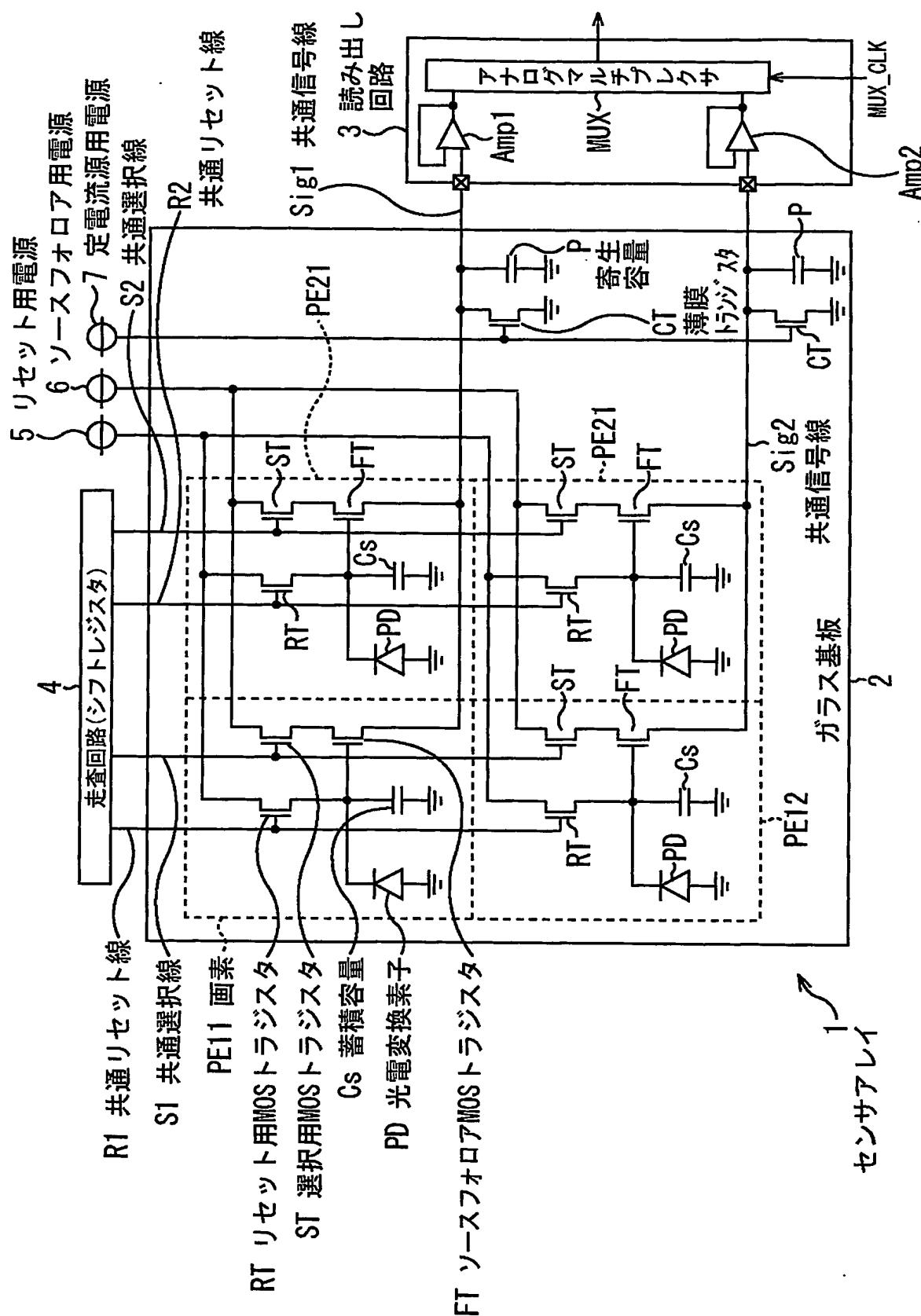
【書類名】図面  
【図1】



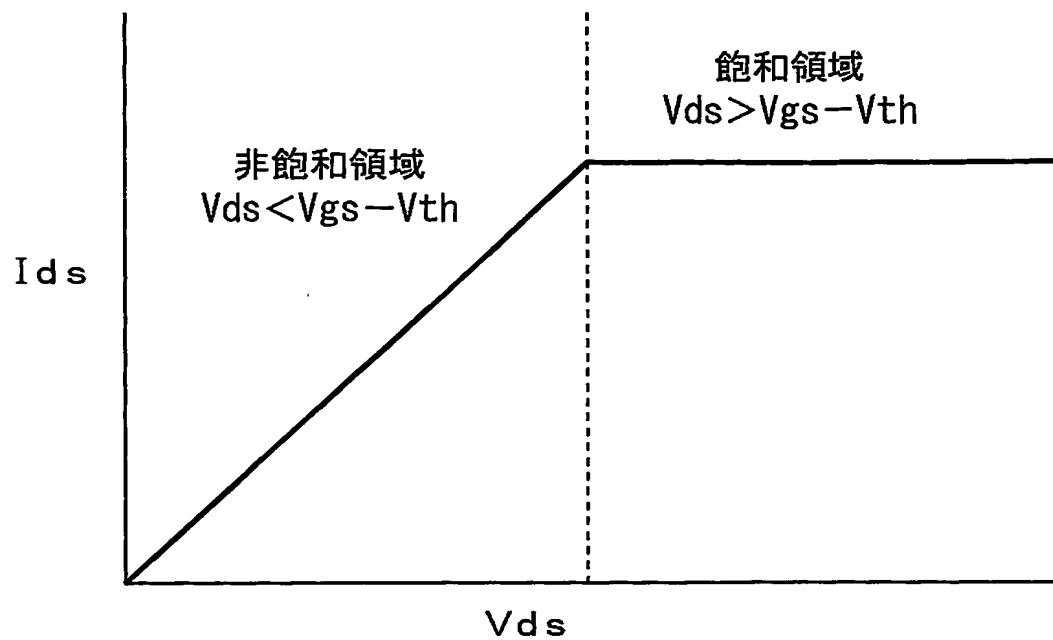
【図2】



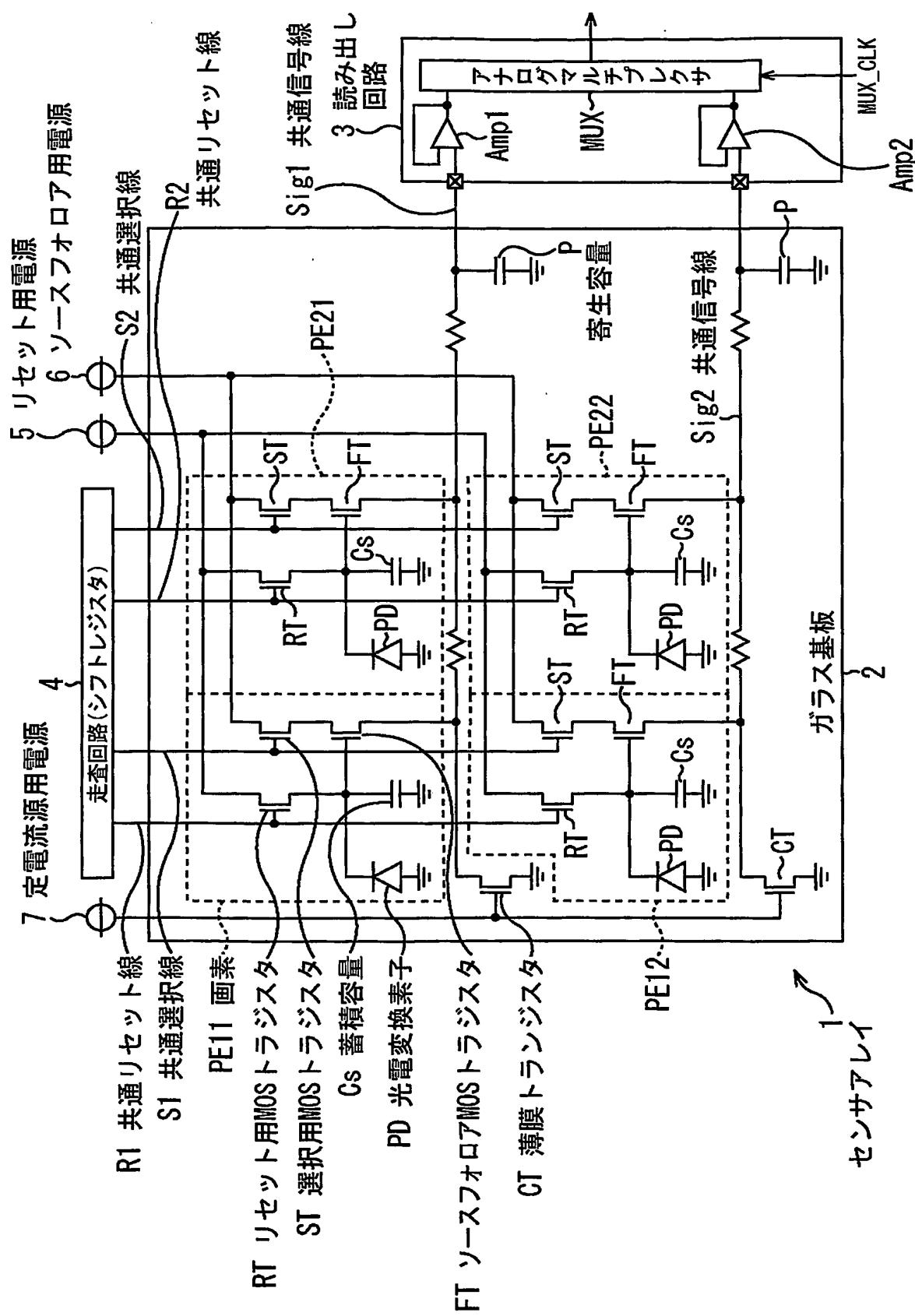
【図3】



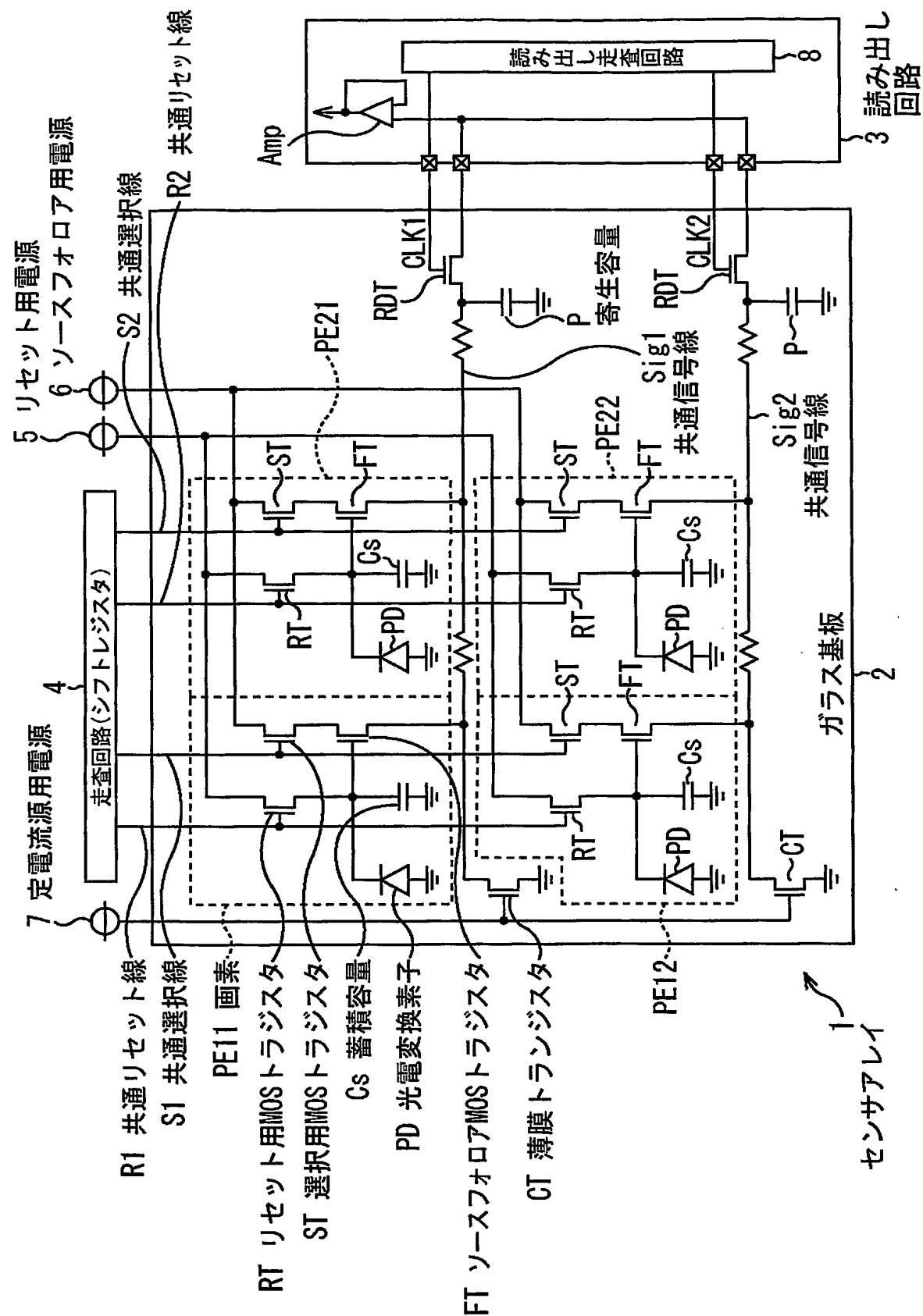
【図 4】



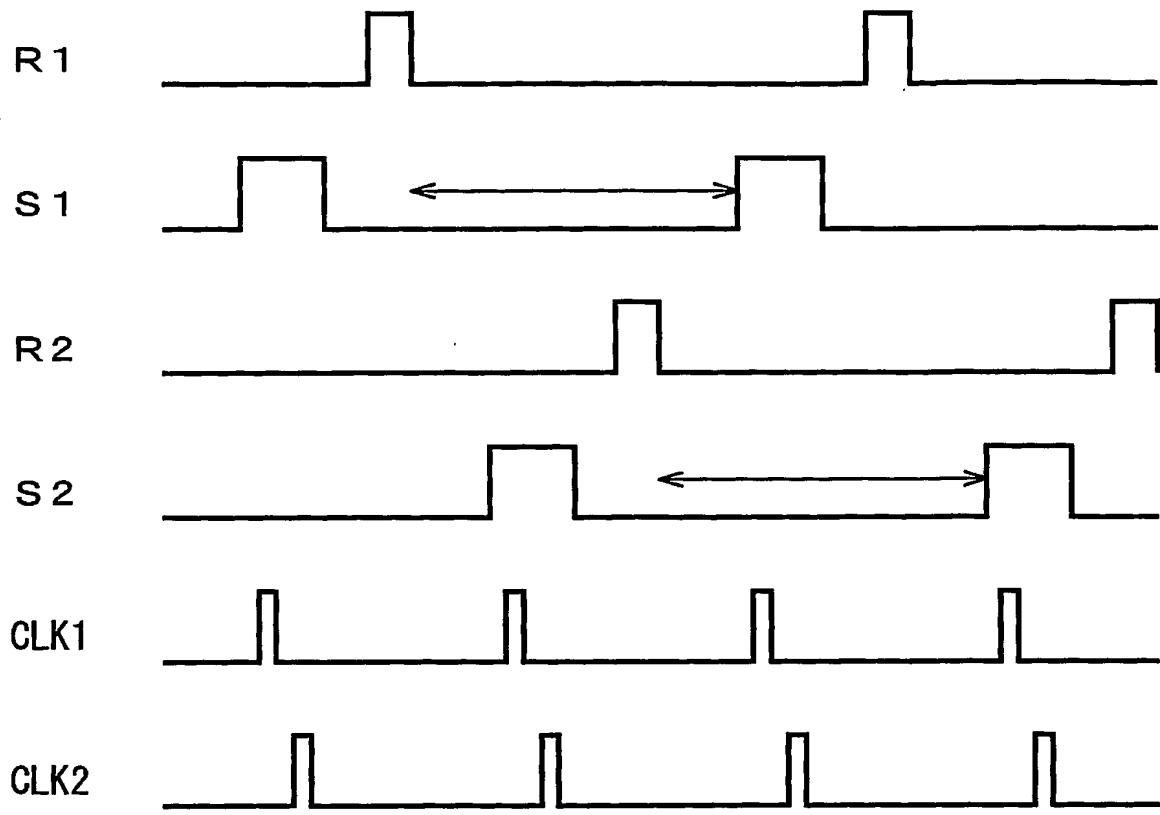
【図5】



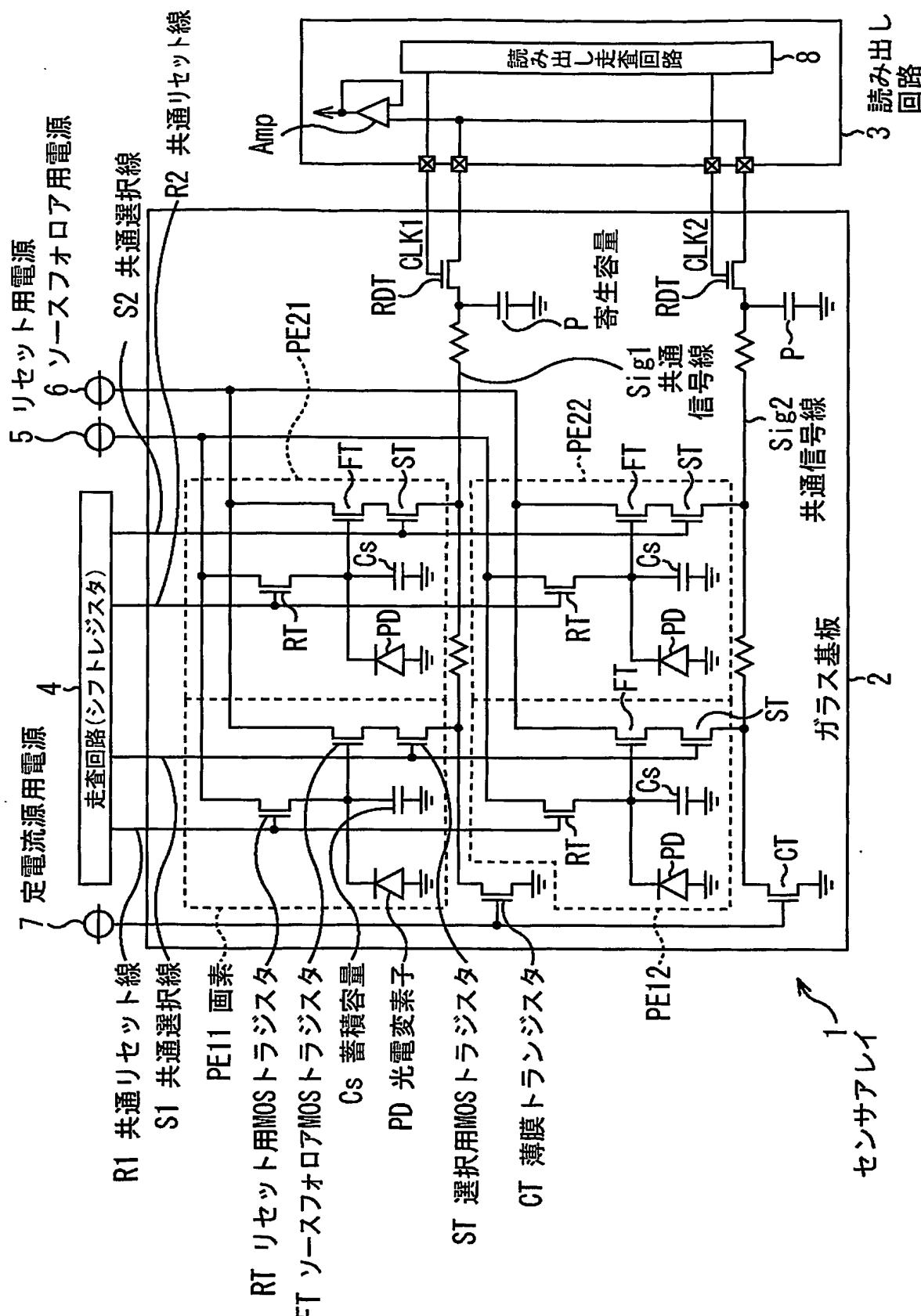
【図6】



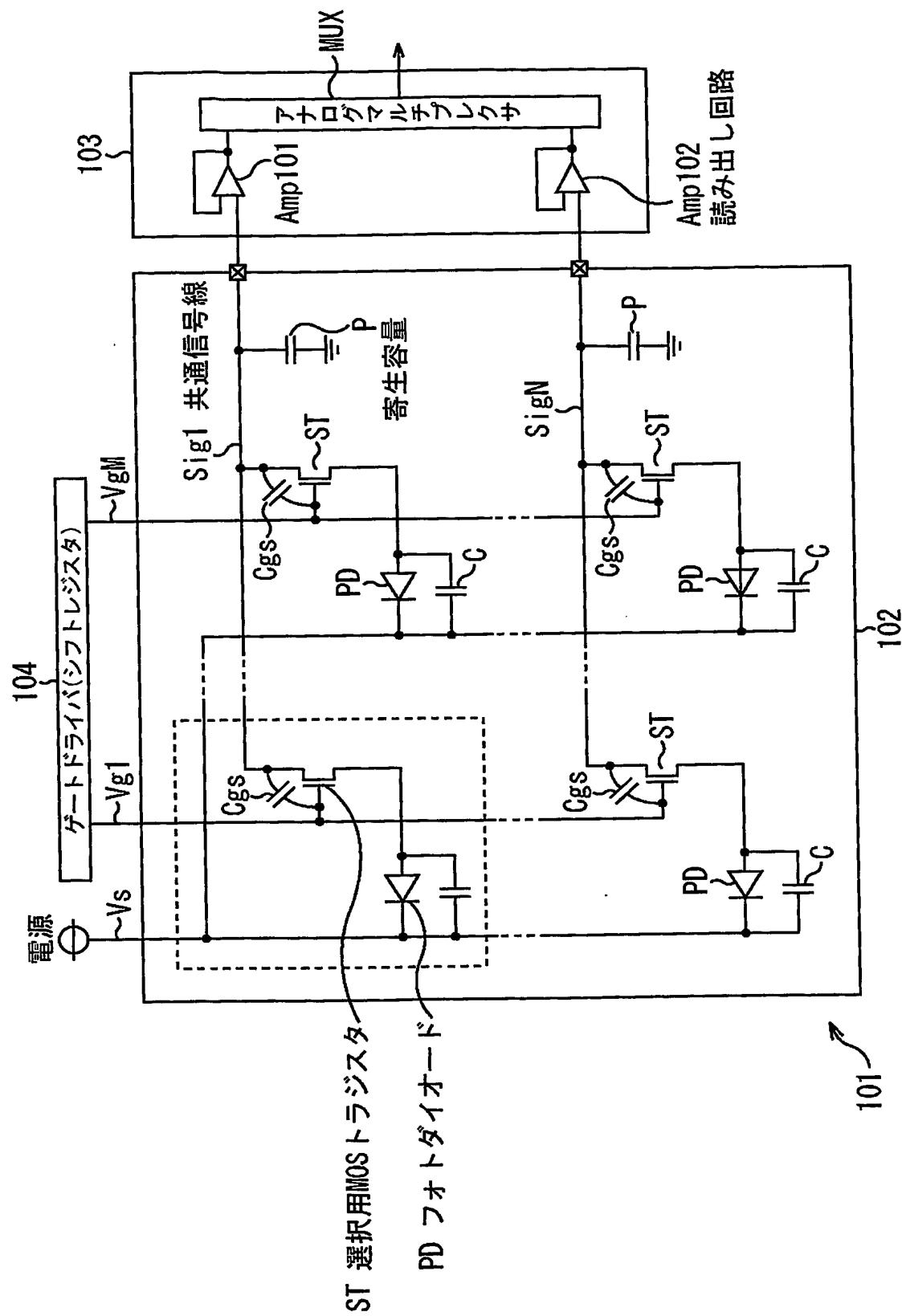
【図7】



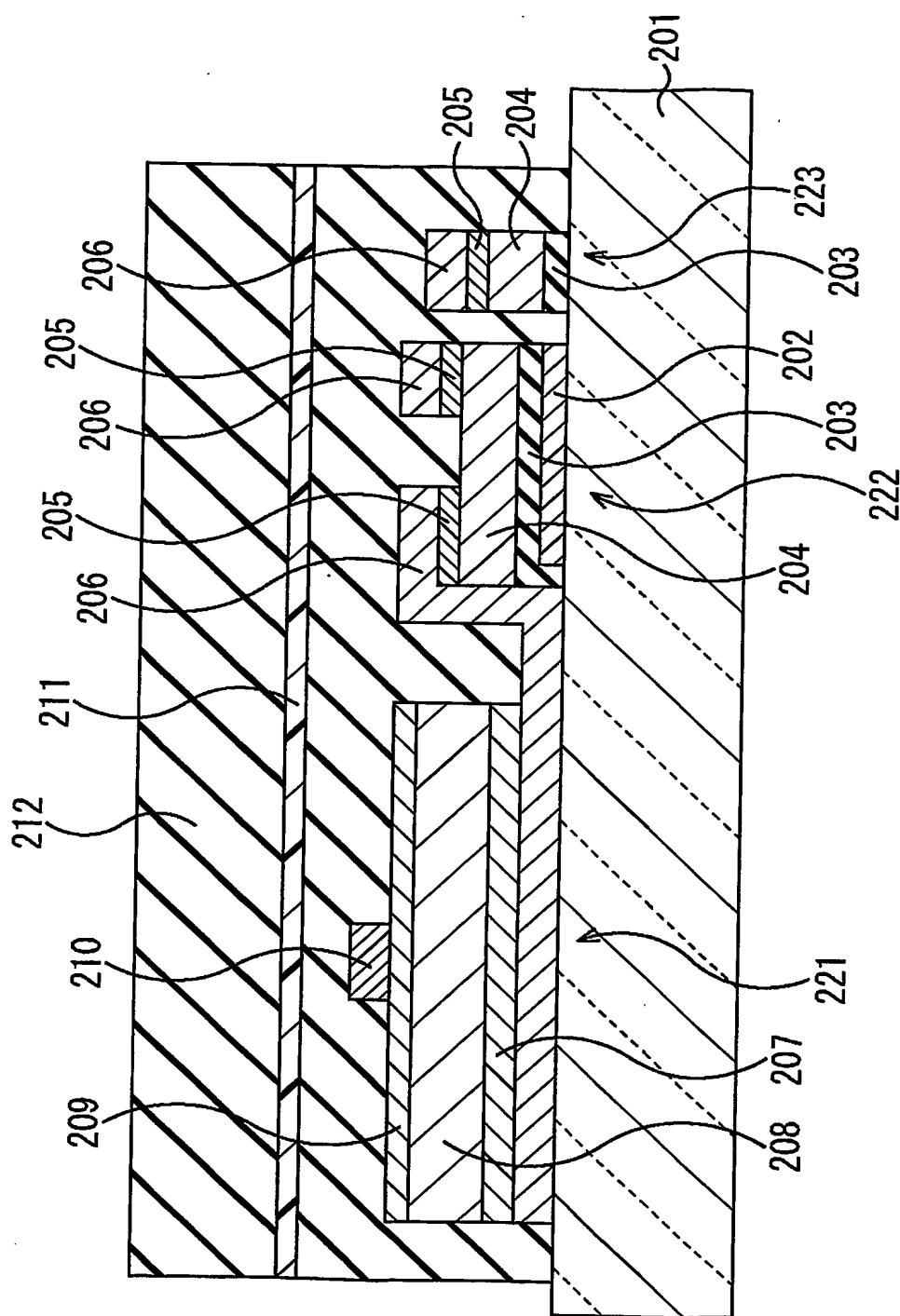
【図 8】



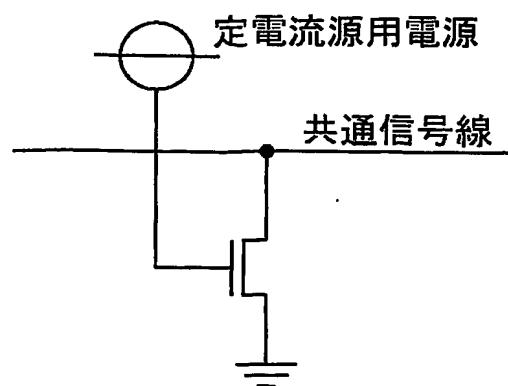
【図9】



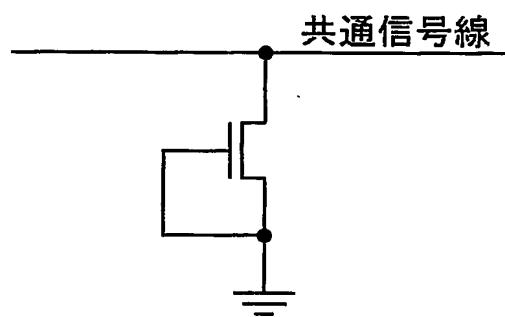
【図10】



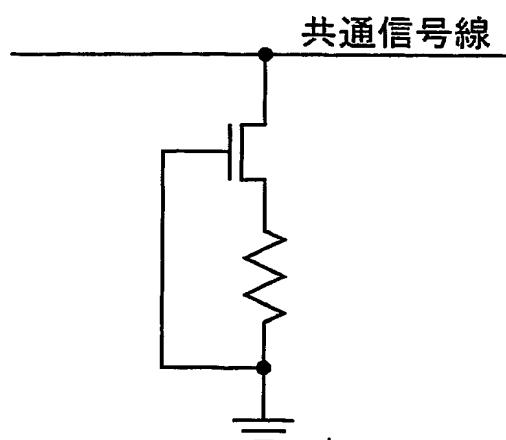
【図 1 1】



【図 1 2】



【図 1 3】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 寄生容量によるノイズの影響を低減することが可能であり、また、簡素な構成で低消費電力の読み出し回路で読み出し可能な光電変換装置を提供する。

【解決手段】 本発明に係る光電変換装置は、光電変換素子と、前記光電変換素子にソースが接続され、ドレインにリセット用電源が接続されるリセット用トランジスタと、前記光電変換素子にゲートが接続され、ドレインに読み出し用電源が接続される読み出し用トランジスタと、前記読み出し用トランジスタのソースに接続された信号線と、前記読み出し用電源又は前記信号線と前記読み出し用トランジスタとの間に接続された選択用トランジスタと、前記信号線に接続された定電流源と、を有することを特徴とする。

【選択図】 図1

特願 2003-389274

出願人履歴情報

識別番号 [000001007]

1. 変更年月日 1990年 8月30日

[変更理由] 新規登録

住所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号  
氏名 キヤノン株式会社